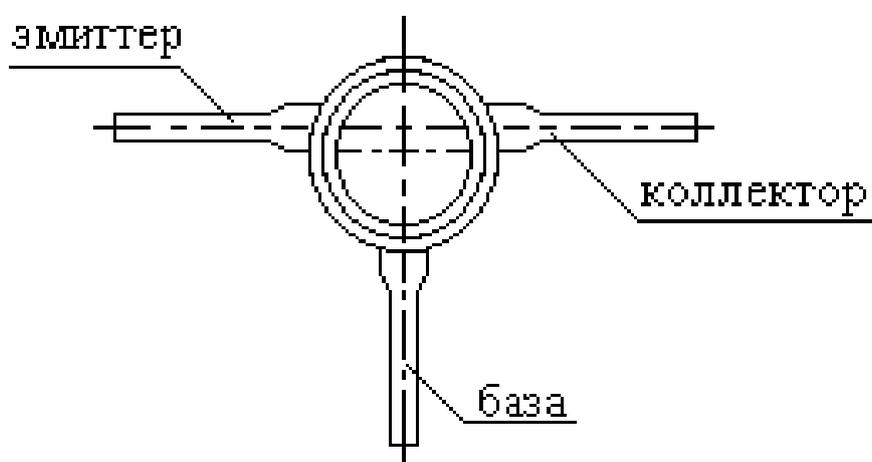


## ТРАНЗИСТОР 2Т371А ОСМ

Кремниевый планарно-эпитаксиальный n-p-n – транзистор 2Т371А ОСМв металлостеклокерамическом корпусе, предназначенный для работы в усилительных схемах.

### Схема расположения выводов



Условная маркировка: одна синяя точка

## ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

при  $t = (25 \pm 10) \text{ }^\circ\text{C}$

| Наименование параметра,<br>единица измерения,<br>режим измерения  | Норма    |          |
|---|----------|----------|
|   | не менее | не более |
| Статический коэффициент передачи тока<br>( $U_{кб} = 1 \text{ В}$ , $I_k = 10 \text{ мА}$ )   | 30       | 240      |
| Обратный ток коллектора, мкА ( $U_{КБ} = 10 \text{ В}$ )  | -        | 0,5      |
| Обратный ток эмиттера, мкА ( $U_{ЭБ} = 3 \text{ В}$ )   | -        | 1        |
| Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте<br>( $U_{кб} = 5 \text{ В}$ , $I_э = 10 \text{ мА}$ , $f = 3 \cdot 10^8 \text{ Гц}$ )                      | 10       | -        |
| Входное сопротивление в схеме с общей базой в режиме малого сигнала, Ом<br>( $U_{кб} = 5 \text{ В}$ , $I_э = 10 \text{ мА}$ , $f = 50\text{-}1000 \text{ Гц}$ ) | -        | 10       |
| Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте, пс<br>( $U_{кб} = 5 \text{ В}$ , $I_э = 10 \text{ мА}$ , $f = 3 \cdot 10^7 \text{ Гц}$ )             | -        | 15       |
| Емкость коллекторного перехода, пФ<br>( $U_{кб} = 5 \text{ В}$ , $f = 10 \cdot 10^7 \text{ Гц}$ )   | -        | 1,2      |
| Емкость эмиттерного перехода, пФ<br>( $U_{кб} = 1 \text{ В}$ , $f = 10^7 \text{ Гц}$ )  | 10       | 1,5      |
| Граничное напряжение, В ( $I_k = 10 \text{ мА}$ )   | 10       | -        |